

40.00



圖一 以去離子水為溶劑時所產生的樹狀銅(樣品 A1) (a)側視角 SEM 影像 (b)俯視角 SEM 影像圖 (c)圖(b)樹狀結構之能量分散光譜圖 (EDS)





圖二 (a)置換反應後產生的氧化鋁顆粒 SEM 影像圖 (b)圖(a)顆粒之 能量分散光譜圖(EDS) (c)表面凹洞之 SEM 影像圖 (d)圖(c)之高倍率 SEM 影像圖



圖三 以去離子水為溶劑時所產生的樹狀銅(樣品 A1) (a)TEM 影像圖 (b)對樹狀結構進行全光束電子繞射所得到的 ED 圖



圖四 樣品 A1 之 XRD 圖譜(* = 未知)





圖五 CTAC 濃度為 0.45 mM 時(樣品 A2)所產生的銅顆粒層 (a)低倍 率 SEM 影像圖 (b)高倍率 SEM 影像圖



圖六 CTAC 濃度為 1.78mM 時(樣品 A3)所產生的奈米銅線(a)低倍率 SEM 影像圖 (b)高倍率 SEM 影像圖 (c)奈米銅線之能量分散光譜圖 (EDX)

keV ------



圖七 CTAC 濃度為 3.56 mM 時(樣品 A4)所產生的奈米銅線 (a)低倍率 SEM 影像圖 (b)高倍率 SEM 影像圖



圖八 反應時間縮短為 2.5 h(樣品 A5) (a)低倍率 SEM 影像圖 (b)高 倍率 SEM 影像圖



圖九 反應時間增長為 3.5 h (a)低倍 SEM 影像圖 (b)圖(a)A 區域之高 倍率 SEM 影像圖 (c)圖(a)A 區域之能量分散光譜圖(EDS) (d)圖(a)B 區域之能量分散光譜圖(EDS)





Zone axis : [013]

圖十 (a)奈米銅線低倍率 TEM 影像圖 (b)奈米銅線高倍率 TEM 影像 圖 (c)圖(b)奈米銅線選區電子繞射圖(SAED)



"Annun

圖十一 樣品 A3 之 XRD 圖譜



圖十二 樣品 A3 之 X 光光電子廣域能譜圖,深實線為 Ar⁺離子濺射前 之樣品;淺實線為 Ar⁺離子濺射後之樣品



電子能譜圖,實線為 Ar⁺離子濺射前之樣品;虛線為 Ar⁺離子濺射後 之樣品



圖十四 HNO3 濃度為 0.5 mM 時(樣品 B1)所產生的團簇 (a)低倍率 SEM 影像圖 (b)高倍率 SEM 影像圖



圖十五 HNO3 濃度為 5 mM 時(樣品 B2)所產生的奈米銅帶 (a)低倍率 SEM 影像圖 (b)高倍率 SEM 影像圖 (c)帶狀產物之能量分散光譜圖 (EDS)



圖十六 (a) HNO₃ 濃度為 10 mM 時(樣品 B3)之 SEM 影像圖 (b) HNO₃ 濃度為 30 mM 時(樣品 B4)之 SEM 影像圖



圖十七 縮短反應時間為 6 h(樣品 B5)初步形成團簇之 SEM 影像圖





圖十八 (a)降低反應溫度為 10℃ 時(樣品 B6)之 SEM 影像圖 (b)升高 反應溫度為 26℃ 時(樣品 B7)之 SEM 影像圖





圖十九 (a) 奈米銅帶低倍率 TEM 影像圖 (b) 奈米銅帶高倍率 TEM 影像圖





圖二十 (a)單根奈米銅帶之高倍率 TEM 影像圖 (b)圖(a)奈米銅帶之 選區電子繞射圖(SAED)(c)圖(a)奈米銅帶之高解析 TEM 圖



圖二十一 樣品 B2 之 XRD 圖譜(* = 未知)



圖二十二 樣品 B2 之 X 光光電子廣域能譜圖



圖二十三 樣品 B2 之(a)Cu 區域 (b)Al 區域 (c)O 區域高解析度 X 光 光電子能譜圖



圖二十五 推測樹狀產物形成過程之示意圖



圖二十六 推測奈米銅線形成過程之示意圖



圖二十七 推測奈米銅帶形成過程之示意圖